

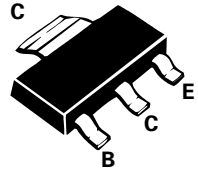
# SOT223 NPN SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTOR

ISSUE 3 – JANUARY 1996

## FZTA14

PARTMARKING DETAIL:- DEVICE TYPE IN FULL

COMPLEMENTARY TYPE :- FZTA64



SOT223

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Emitter Voltage	$V_{CES}$	30	V
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	30	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	30	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	10	V
Continuous Collector Current	$I_C$	1	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ ).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CES}$	30			V	$I_C=100\mu\text{A}$ , $V_{BE}=0$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			100	nA	$V_{CB}=30\text{V}$ , $I_E=0$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			100	nA	$V_{EB}=10\text{V}$ , $I_C=0$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			1.5 1.6	V V	$I_C=100\text{mA}$ , $I_B=0.1\text{mA}^*$ $I_C=1\text{A}$ , $I_B=1\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$			2.0	V	$I_C=100\text{mA}$ , $V_{CE}=5\text{V}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			2.0 2.2	V V	$I_C=100\text{mA}$ , $I_B=0.1\text{mA}$ $I_C=1\text{A}$ , $I_B=1\text{mA}$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	10K 20K 5K				$I_C=10\text{mA}$ , $V_{CE}=5\text{V}^*$ $I_C=100\text{mA}$ , $V_{CE}=5\text{V}^*$ $I_C=1\text{A}$ , $V_{CE}=5\text{V}^*$
Transition Frequency	$f_T$		170		MHz	$I_C=50\text{mA}$ , $V_{CE}=5\text{V}^*$ $f=20\text{MHz}$

\*Measured under pulsed conditions. Pulse Width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$

Spice parameter data is available upon request for this device

For typical characteristics graphs see FMMT38C datasheet.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9